

本社:〒160-8366 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビルディング

報告書番号: PCN#201004200032011年1月7日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 営業・技術本部 カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 **(状**)

HPA(ハイパフォーマンスアナログ) ADS12xx 製品 前処理サイト変更のご案内

(初版 PCN20100420003 2010 年 4 月 23 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了 の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が 延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より 30 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前24ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。 また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは<u>pcn_tij@list.ti.com</u>にお問い合わせ 下さい。

以上

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

通知タイプ	☐Initial notice (Plan)	■Final notice		
	Design/Specification	□Design	□Electrical	□Mechanical
	■Wafer Fab	■Site	□Process	□Material
変更概要	Wafer Bump	□Site	□Process	□Material
发 义 似 女	Assembly	□Site	□Process	□Material
	Test	□Site	□Process	
	Others	□Packing/Shipp		□ -
	HPA(ハイパフォーマンスアナログ) ADS12xx製品 前処理サイト変更			
変更内容	現行 : OKI社(日本)			
	変更後:TI-Sherman(米国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	□計画	■終了		
製品表示	□変更無し	■変更あり		
備考		·		

変更内容 内容:弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) ADS12xx製品の前処理サイトについて、現行 OKI社(日 本)サイトにおいて5インチウェーハを使用して製造いたしておりますが、OKI社プロセス製造終了及 び供給能力確保の為に、これに替えて、TI-Sherman(米国)サイトにおいて6インチウェーハを使用し た製造に移行し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差),外観,動作特 性, 品質, 信頼性への影響はありません。

> 変更内容 変更後 現行 前処理サイト OKI社(日本) TI-Sherman(米国) ウェーハサイズ 5インチ 6インチ

理由: OKI 社プロセス製造終了及び供給能力確保の為

対象製品リスト

<u>//1 = // 3 // 1 // 1 // 1 // 1 // 1 // 1</u>				
対象製品名				
ADS1201U	ADS1210U/1KG4	ADS1211U	ADS1212U/1KG4	ADS1213U
ADS1201U/1K	ADS1210UG4	ADS1211U/1K	ADS1212UG4	ADS1213U/1K
ADS1201U/1KG4	ADS1211E	ADS1211U/1KG4	ADS1213E	ADS1213U/1KG4
ADS1201UG4	ADS1211E/1K	ADS1211UG4	ADS1213E/1K	ADS1213UG4
ADS1210P	ADS1211E/1KG4	ADS1212P	ADS1213E/1KG4	
ADS1210PG4	ADS1211EG4	ADS1212PG4	ADS1213EG4	
ADS1210U	ADS1211P	ADS1212U	ADS1213P	
ADS1210U/1K	ADS1211PG4	ADS1212U/1K	ADS1213PG4	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト記号(ラベルの"20L"の箇所)及び生産国記号(ラベルの"21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は、下記の様になります。

	現行	追加認定
Fab Site: 前処理サイト	OK I	TI-Sherman
Chip Site Origin (20L): 前処理サイト記号	OKI	SHE
Chip Country Origin (21L): 生産国記号	JPN	USA



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信賴性試験結果					
信頼性試験期間 開始	2009年3月 終	了 2	2010年12月21日		
	信賴性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1201U	ADS1210U			
Die Size (mm):	3.6322 X 6.2992				
Wafer Fab Site:	SFAB: SH-BIP-1	SFAB: SH-BIP-1			
Passivation:	10.75kASiN	10.75kASiN			
Metallization: 5kA AlCu0.5%/725ATiW /600ATi		5kA AlCu0.5%/725ATiW /600ATi			
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
Reliability Test	Condition / Duration	ADS1201U	ADS1210U		
Electrical Characterization	Over Temp	10/0	10/0		
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Approved	Approved		

信賴性試験結果						
信頼性試験期間 開始	2009	年3月 終	了	2010年	2010年12月21日	
信頼性試験 — 試料構成詳細						
Qual Device: ADS	1211U					
Wafer Fab Site: SFAE	3: SH-BIP-1	Die Size (mm): 3.6322 X 6	6.2992		
Passivation: 10.75	ikASiN	Metallization	n: 5kA AlCuC	5kA AlCu0.5%/725ATiW /600ATi		
	信頼	質性試験結果				
Reliability Test	Condition	Condition / Duration		Sample Size/ Fails		
Reliability Test	Condition			Lot#2	Lot#3	
**Steady-state Life Test	150C,	300 Hrs	80/0	80/0	80/0	
Electrical Characterization	Ove	Over Temp		10/0	-	
Electrical Characterization	Over Temp		30/0	-	-	
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs		85/0	85/0	85/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		85/0	85/0	85/0	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		85/0	85/0	85/0	
**Temp Cycle	-65C/150	C, 500Cyc	77/0	77/0	77/0	
ESD HBM	20	V00V	3/0	3/0	3/0	
ESD CDM	500v		3/0	3/0	3/0	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	76/0	76/0	
Die Shear	-		10/0	10/0	10/0	
Latch-up	per JESD78		6/0	-	-	
Manufacturability	per mfg. Site	e specification	Approved	Approved	Approved	
Manufacturability (Wafer Fab)		-	Approved	-	-	
Note: ** Preconditioning required, JEDEC Level-1 / 220C						

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果					
信頼性試験期間開始	2009年3月 糸	冬了	2010年12月21日		
	信頼性試験 — 試料構成詳約	H			
Qual Device:	ADS1212U	ADS1213U			
Die Size (mm):	3.6322 X 6.2992	3.6322 X 6.2992			
Wafer Fab Site:	SFAB: SH-BIP-1				
Passivation: 10.75kASiN		10.75kASiN			
Metallization: 5kA AlCu0.5%/725ATiW /600ATi		5kA AlCu0.5%/725	5kA AlCu0.5%/725ATiW /600ATi		
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample	Sample Size/ Fails		
Reliability Test	Condition/ Ediation	ADS1212U	ADS1213U		
Electrical Characterization	Over Temp	10/0	10/0		
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Approved	Approved		